



Transistor NPN Epitaxial / 30 MHz / 13.5 Vcc / 70 W / Encapsulado T-40E

SKU: 25C2097 Categoría: KENWOOD / ICOM / TXPRO

\$849.96

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Este transistor NPN epitaxial de silicio está diseñado para aplicaciones de amplificación de radiofrecuencia de potencia con alta eficiencia energética. Opera a una frecuencia máxima de 30 MHz con estabilidad térmica y eléctrica garantizada por su estructura epitaxial de silicio. La tensión de colector de 13.5 Vcc permite integrarlo en etapas de salida de transmisores y amplificadores de RF que requieren manejo de señales de alta potencia. Su encapsulado T-40E proporciona disipación térmica eficiente para operación continua en entornos industriales exigentes.

Características Principales

- Transistor NPN epitaxial de silicio para baja distorsión armónica
- Frecuencia máxima de operación: 30 MHz
- Tensión de colector: 13.5 Vcc
- Potencia máxima de salida: 70 W
- Encapsulado formato T-40E para montaje industrial
- Optimizado para amplificación RF de potencia

Especificaciones Técnicas

Transistor NPN Epitaxial de Silicio	Tipo de Transistor
30 MHz	Frecuencia Máxima
13.5 Vcc	Tensión de Colector
70 W	Potencia de Salida
T-40E	Encapsulado
Amplificación RF de Potencia	Aplicación Principal

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Alta eficiencia en amplificación RF de potencia
Característica 2	Operación estable hasta 30 MHz
Característica 3	Diseño epitaxial de silicio para baja distorsión
Característica 4	Encapsulado T-40E para disipación térmica optimizada
Característica 5	Tensión de colector 13.5 Vcc para circuitos robustos
Característica 6	Ideal para etapas de salida en transmisores